文章编号: 1001-3806(2007)06-0600-04

溶胶凝胶法制备 Yb³⁺ /Er³⁺ 共掺氧化铝材料的光谱性质

毛艳丽,林丙臣,冯素雅,程永光 (河南大学物理与信息光电子学院,开封 475004)

摘要:为了得到更加有效的掺饵光波导放大器材料,采用改进了激活剂掺入途径的溶胶凝胶方法,制作了不同比例 Yb³⁺ /E³⁺ 共掺杂的 Y 相氧化铝粉体材料方法,测量了样品的吸收和光致发射光谱并进行了分析。结果表明, Yb³⁺ 离子 的掺入能很大地提高样品对 980m 左右激发光的吸收效率, E³⁺ 离子 1534nm 主发射峰的发射强度最大增加了约 6 3 倍;体系中 Yb³⁺:E³⁺的掺杂存在最佳比例,最佳掺杂比例约为 6 t 同时 X 射线衍射法测试表明,最佳的热处理温度为 900°C,相同的热处理温度下, Yb³⁺ 的掺入能延缓 A $_{1}O_{3}$ 由无定形相向 Y 相转变的过程,这一结果对进一步改善掺饵光波导放大器的特性是有帮助的。

关键词: 激光物理; 光波导材料; 溶胶 凝胶法; 氧化铝; 稀土 中图分类号: 0433 5 文献标识码: A

The spectroscopic property of erbitm ytterbitm co-doped alum in a material prepared by sol-gel process

MAO Yan–li, LIN B ing–ch en, FENG Su–ya, GHENG Yong–gu ang

(School of physics and information Optoe lectronics, Henny University, Kaifeng 475001, China)

Abstract The alm in a pow der ∞ -doped with different ratio of $(A^{3+}/E)^{2+}/E)^{2+}$ was prepared with an advanced sol-gelme hod as batterm aterial used for Er^{3+} doped waveguide amplifier. The absorption and emission spectra ware measured and analysed. The result indicated that the incorporation of Yb³⁺ could enhance the absorption of 980nm exciting light for the Er^{3+} and Yb³⁺ ∞ -doped alum ina pow er the photolum inescence peak intensity at 1533 nm was increased by a factor of about 6.3 compared with that of the Er^{3+} doped alum ina pow ders And optimum ratio of the Yb³⁺ : Er^{3+} was 6.1 for this method. The X-ray diffraction spectra show that the best them all treatment temperature was 900°C, and the incorporation of Yb³⁺ could postponed the forming of Y-phase at 900°C them all treatment condition. The result is helpful form aking more effective Er^{3+} doped waveguide amplifier.

Keywords has er physics, waveguide materials, sol-gel alm in a rare-earth

引 言

光波导放大器是继半导体光放大器、光纤放大器 之后又一种新型的光放大器,它具有体积小易于集成、 单位长度增益高、成本低等优点。工作于 1534nm 左 右的掺铒光纤放大器 (erbiun doped waveguide amplifier, EDFA)进入实用阶段后,随着通信技术及信息流 量的增大,掺铒光波导放大器 (erbiun doped fiber amplifier, EDWA)在通信中应用的研究工作已经引起了 人们广泛的兴趣^[1~4]。为了实现单位长度的高增益, EDWA中必须实现高浓度的 Er^{3+} 掺杂浓度,通常比 EDFA 中的浓度高两个数量级^[5,6]。传统的掺铒硅基 材料在高浓度掺杂时由于稀土离子的团簇效应, Er^{3+}

作者简介: 毛艳丽 (1972-), 女, 副教授, 主要从事激光材 料和激光技术等方面的科研工作。

E-mail y had@henu.edu cn

收稿日期: 2006-10-8 收到修改稿日期: 2006-11-02

离子会出现浓度淬灭现象。目前已找到许多掺 Er³⁺ 离子的基体材料,如 Si SO₂、磷硅玻璃、钠钙硅玻璃、 $LNbO_3$, Y_2O_3 , $A\downarrow O_3^{[7]}$ 、磷铌酸盐玻璃^[8]等, 而其中尤 以 A 103作为基体材料的 EDWA 更加引起人们的兴 趣。选择 AbO3作为制作波导的基体材料具有如下优 点: (1)芯层与缓冲层、覆盖层 (SO₂)之间的折射率反 差较大,导致波导膜的高约束低损耗,从而实现有效的 抽运和放大; (2)高折射率反差可允许小的波导弯曲 半径,使得制作微小的波导元件成为可能;(3)A bO₃ 和 EpO的原子价相同,晶体结构相似,可将高浓度的 Er^{3+} 离子结合进 AbO3晶体结构中,从而在较短的尺寸 内得到较高的增益。但是由于 Er³⁺ 离子对 980mm 激 发光较小的吸收截面和强烈的激发态吸收,抽运效率 很低^[9], 解决办法之一是共掺一定浓度的 Yb^{3+} 离子, 利 用其在 980nm 左右较大的吸收截面和 Yb^{3+} ($^{2}F_{7/2}$ ^{→ 2}F_{5/2})发射与 E³⁺ (⁴ I_{15/2}^{→ 4} I_{3/2})吸收较大的光谱重 叠, 实现 $Yb^{3+ \rightarrow} Er^{3+}$ 间的能量传递。作者通过 $Er(NO_3)_3$ 和Yb(NO_3)₃溶液的形式引入 Er^{3+} 和 Yb³⁺ 离子, Er^{3+} 与 Yb³⁺之间的比例在不同的基质中采用不 同的制作工艺会有所不同, 实验确定了这种溶胶凝胶 法制作的氧化铝材料中最佳的 Yb³⁺ : Er^{3+} 比例, 为制 作高性能 Er^{3+} 掺杂氧化铝波导放大器创造条件。

1 样品的制备和测试条件

1.1 样品的制备

将称量好的异丙醇铝 (Al(OC₃H₇)₃)放入定量 的预热至 90℃的 3次蒸馏水中,摩尔比(以下比例均 为物质的量的比) $n(H_2O):n(Al(OC_3H_7)_3) = 110:1$, 90℃水浴加热条件下回流搅拌,使其水解 2h 形成白 色的 ¥-A DOH 沉淀; 敞开容器口, 剧烈搅拌 1h 使水解 反应生成的异丙醇充分的挥发;滴加定量的硝酸,使 Y-A DOH 脱溶, $n(H^+)$: $n(A_1^{3+}) = 0$ 15:1; 90℃水浴加 热下回流搅拌 16h 形成稳定的澄清透明的 ¥-A DOH 溶胶; 加入计算量的 0 5mol/L 的 Er(NO₃)₃ 和 Yb(NO₃)₃溶液, 搅拌形成 Yb³⁺ /Er³⁺ 共掺的 Y-A DOH 溶胶 (不同于以往的以加入固体 Er(NO₃)₃和 Yb(NO₃)₃引入 Er³⁺和 Yb³⁺的方法^[10]); 胶体放入马 弗炉中,在 100℃下保温 6h,使胶体中大部分水分挥发 后,以 4℃ /m in的升温速率升至 900℃保温 2h, 随炉降 至室温:研磨成粉,得到在固定 Er^{3+} 离子摩尔分数为 0 01条件下 n(Yb³⁺):n(Er³⁺)比例为 0, 1, 2, 4, 6, 8 的 Yb³⁺ /Er³⁺ 共掺 y-AbO3 粉体材料。

1.2 测试条件

吸收光谱采用法国 N arian公司的 Carry-5000型紫 外-可见-近红外分光光度计测量: 红外与上转换采用 美国 J-Y公司的 F horolog3-Tau稳态-瞬态荧光光谱仪 测定, 抽运光源为 450W 的氙灯: X 射线衍射法 (X-ray diffraction, XRD)测试采用国产 DX-2500型 X 射线衍 射仪。所有测试均在室温下进行。

2 结果与分析

21 吸收光谱

图 1为掺杂 Er³⁺离子 Y-A bO₃ 粉末在 300nm~





1000nm 间的吸收谱, 从图中可以清晰地观察到 Er^{3+} 离子 4f电子由基态⁴ I_{15/2}向²K_{15/2}, ⁴G_{11/2}, ²H_{9/2}, ⁴F_{3/2}, ⁴F_{7/2}, ²H_{11/2}, ⁴S_{3/2}, ⁴F_{9/2}, ⁴ I_{1/2}激发态能级跃迁所对应的 365nm, 377nm, 407m, 451nm, 488nm, 521nm, 541m, 653nm, 800nm, 975nm 处的吸收。同时可以观察到随 着 Yb³⁺浓度的增大, 样品在 975nm 左右的吸收逐渐增 强, 吸收范围也在展宽, 这得益于 Yb³⁺离子²F_{7/2} \rightarrow ²F_{5/2} 跃迁较大的吸收截面, 它能有效地增强体系对现代通 讯系统中用作放大器抽运光源的 980nm 半导体激光 的吸收效率, 1529nm 左右 Er^{3+} 离子⁴ I_{15/2}能级的吸收峰 强度基本没有变化。

2 2 光致发射谱



图 2为室温下不同 Yb³⁺ /Er³⁺掺杂比例样品在相

√Fig 2 The PL spectra of samples with different ratio of Y b³⁺ /E r³⁺ co-doped

同的激发条件下的光致荧光 (photot lum inescence, PL) 发光光谱, 与 980mm 半导体激光器激发有所不同, 450W 氙灯配合光栅单色仪选择的 976m 激发光较 弱,但这可能更加符合集成光学中 EDWA 的真实工作 环境。从图中可以看出样品在 1450nm~ 1650m 间存 在一个峰值为 $1533 \,\mathrm{m}$ 的较宽的发射峰,这是 Er^{3+} 离 子内层 4 f组态电子由激发态⁴ I_{13/2}向基态⁴ I_{15/2}跃迁的 结果。由于 Yb³⁺ 掺入, 样品在 1533nm 的主发射峰强 度与单掺 E r³⁺相比有了很大的增强,最大增强为原来 的 6 3倍, 这是由于 Yb³⁺ 离子在 980nm 左右存在一个 较宽的吸收范围和很大的吸收截面,它能有效的吸收 980mm 左右的抽运光, 而 Yb³⁺ 与 E_r^{3+} 之间存在的能量 传递过程²F_{5/2}(Yb³⁺) + ⁴I_{5/2}(Er³⁺) \rightarrow ²F_{7/2}(Yb³⁺) + ⁴ I_{11/2}(E r³⁺) 可以将 Yb³⁺离子吸收的抽运能量有效 地传递给 E_r^{3+} 离子, 它比 E_r^{3+} 离子直接吸收抽运能量 的⁴ $I_{15/2}$ · ⁴ $I_{11/2}$ 过程要有效得多,这种 Yb³⁺ · E³⁺ 之间 的能量传递效率可以高达 95% [11]。同时可以看出, 1533mm 发射强度并不是简单的随 Yb³⁺ /Er³⁺ 掺杂比 例的增加而单调增加,他们之间存在一个最佳比值。 从图中可以看出,这个最佳比值为 6:1,图 3中 a线所 示为不同 Yb³⁺ /Er³⁺ 掺杂比例样品 1533nm 处的峰值 强度以及根据它们所拟合得出的曲线, 拟合曲线的峰



Fig 3 The FWHM and peaks intensity of samples with different ratio of Y b^{3+} /E r^{3+} co-doped

值为 5.93。对于不同基质以及采用不同方法制备的 Yb³⁺ /Er³⁺ 共掺材料中最佳 Yb³⁺ /Er³⁺ 比例, 文献报道 的差别较大,但 TNG 等人有关 $solgel法制备 Yb^{3+}$ / E_r^{3+} 共掺 TO₂ 薄膜^[12] 以及 LI等人关于固熔法制备 Yb^{3+}/Er^{3+} 并掺硅酸盐玻璃[13]的研究表明, 光致发光 最强时对应的最佳 Yb^{3+} /E r^{3+} 掺杂比例为 6.1 与本文 中的结果一致。只有最佳 Yb^{3+} /E r^{3+} 掺杂比例时, 才 能实现 Yb³⁺离子对 Er³⁺离子的有效包围, 形成合理分 布的 Yb^{3+} -E r^{3+} 离子对, 进而实现 Yb^{3+} → E r^{3+} 的最有 效的能量传递。继续加大 Yb^{3+} 离子的掺入量, 当 Yb^{3+} 比例过高,超出 Er^{3+} 离子周围所能容纳的数目 时, 过剩的 Yb³⁺ 离子会发生团聚, Yb³⁺ 离子之间会发 生能量传递,从而降低了 $Yb^{3+ \rightarrow} Er^{3+}$ 能量传递的效 率,降低了抽运功率的利用率。图 3中 b线所示为不 同比例 Yb³⁺ /Er³⁺ 共掺样品光致发光谱线半峰全宽的 变化趋势,从图中可以看出,Yb³⁺离子的掺入能明显 的加大样品的半峰全宽(full width half maxium, FWHM), 半峰全宽从不掺 Yb3+离子的约 38nm 增加到 共掺后的 51mm, 这是由于 Yb³⁺离子的掺入改变了 Er³⁺离子的局域晶体场环境,引起了光谱的非均匀展 宽。但是这种影响是有限的,随着掺入 Yb³⁺ 离子浓度 的增加, FWHM 基本不再变化。

23 X射线衍射谱

图 4示为用不同温度热处理过的单掺 Er³⁺离子



Fig 4 The XRD spectra of Er^{3+} single doped samples with different the rmal treatment condition

样品的 XRD 谱图, Er³⁺离子的摩尔分数为 0 01, 从图 中可以看出, 在最低 700℃热处理下, 样品已经出现 $y-A_{b}O_{3}$ 相 (JCPDS No 29-0063)的特征峰,随着处理 温度的升高,(440)及(400)晶面衍射峰的强度变大, $y-A_{b}O_{3}$ 相结构得到增强,900℃热处理条件下可以得 到较为理想的 $y-A_{b}O_{3}$ 相结构。继续升高热处理温度 至 1000℃后,谱图中开始出现 20= 32 929°和 20= 50.717°的衍射峰,通过查阅标准图谱,可以确定是 $\theta-A_{b}O_{3}$ 结构(JCPDS No 11-0517)中的(204)和(132) 晶面衍射,这证明 1000℃热处理温度下,样品中出现 了 $\theta-A_{b}O_{3}$ 结构,体系开始转变为 θ 和 y相的混合相。 1200℃热处理下,体系已经转变为多种晶相的混合,包 括 $\alpha-A_{b}O_{3}$ 和析出的 $ErA_{b}O_{3}$ (JCPDS No 32-0012)等晶相。

图 5为 900℃热处理, E^{r³⁺}的摩尔分数为 0 01时, 不同 Yb³⁺ :E^{r³⁺}离子掺杂比例对体系相结构的影响。



Fig 5 The XRD spectra of samples with different ratio of ${\rm Yb}^{3+}$ / ${\rm E}\,r^{3+}$ co-doped

图中可以看出, 随着 Yb³⁺ 离子掺入量的增加, Y=A lO_3 相中(400)和(440)晶面的衍射峰有所减弱, 且(440) 晶面衍射强度减弱的速度快于(400)晶面。整体看, Y=A lO_3 相的特征衍射峰都在弱化, 对比两图晶相发展 变化的趋势可以发现, 提高热处理温度和加大掺杂量 对晶相的影响作用是相反的, 作者认为这是高掺杂引 起的体系相变温度提高的结果, 这与 OKADA 报道的 大尺寸离子如 C s³⁺ 和 Ba²⁺ 掺杂能导致 A lO_3 相变温 度提高的结果 相一致¹¹⁴。可以推测该体系中随着 Yb³⁺ 离子掺入量的增加, 热处理温度应该适当的提高 以得到较好的 Y相。

3 结 论

(1)用改进的溶胶凝胶法制备了铒镱共掺 $Y_{-A} \downarrow_{O_3}$ 粉体材料,实验表明材料中的 Yb³⁺能有效的增强 E³⁺ 对 980nm激发光的吸收, Yb³⁺ /E³⁺ 共掺样品中 E³⁺ 离子的 1533nm主发射峰强度增大为单掺 E³⁺离子时 的 6.3倍。

 (2)通过本文中的溶胶凝胶法制备的 E³⁺ Yb³⁺ 共
 掺 Y-A bO₃材 料中 Yb³⁺ : E³⁺ 的比例存在最佳值, 实 (下转第 606页) 的信噪比提高了 33.67%,而且速度明显提高,减少内存占用,增强了系统的实时性。采用微分联合变换相关器进行图像识别时,微分作用可以很好地消去零级峰,突出相关峰,但是输出噪声很大,不适合单独使用,结合功率谱的二值化操作,即能得到理想的结果。

6 结 论

传统的二元联合变换相关器中,在对联合功率谱 进行二值化处理时,对阈值的选取要求较高,阈值的确 定影响系统的实时性,已经成为二元联合变换相关器 的瓶颈。结合对联合功率谱进行微分处理和二值化处 理,提出了一种新的二元联合变换方法——二元离散 变换相关器,而且在对联合功率谱进行结合微分操作 和二值化处理前,先用指数高通滤波函数对功率谱进 行滤波。理论分析和模拟结果表明,改进后的算法使 识别效果得到了改善,而且实时性明显提高。

参考文献

- [1] LEIF, ITON M, YATAGA IT. A dap tive binary joint transform correlator for in age recognition [J]. Appl Opt 2002, 41(35): 7416 ~ 7421
- [2] MEIA C L, EMMIC C. A distortion-tolerant photorefractive joint transform correlator [J]. J Optics A: Pure and Applied Optics 2004 6

(上接第 602页)

验发现此值为 6:1。

(3)900℃热处理条件下高浓度掺杂的 Xb³⁺ 对体 系相结构影响不大,但是它延缓了 ¥相的形成,提高 了相变的温度。

参考文献

- [1] YAN Y C, FABER A J de WAAL H Erbium-doped phosphate glass waveguide on silicon with 4. 1dB/en gain at 1. 533µm [J]. A P L 1997, 71 (20): 2922~2924
- [2] WONG S E, PUNE Y B, CHUNG P S Er³⁺ -Yb³⁺ codoped phosphate g lass waveguide amplifier using Ag⁺ -Li⁺ ion exchange [J]. EEE Photon ics Technology Letters 2002, 14(1): 80~82
- [3] HEMPSTEAD M. Ion-exchanged g lass waveguide lasers and amplifiers
 [J]. SP E, 1997, 2996: 94 ~ 102
- [4] VANDENHOVEN G N, SNOEKS E, POIMAN A et al U peonversion in Er-in p kn ted A ½ O₃ waveguides [J]. JA P, 1996 79(3): 1258~ 1266
- [5] OHTSUKI T, HONKANEN S, NAJAFI S Cooperative upconversion effects on the performance of E³⁺ -doped phosphate glass waveguide amplifiers [J]. J O S A, 1997, B14(7): 1838~ 1845.
- [6] Q U H W, YANG P Zh, ZHONG H Y et al. Influence of annealing and doping on Yb: YAG [J]. Chinese Journal of Lasers, 2002, 29(5):

术

- [3] SHABTAY G, MENDLOVID D, ZALEVKY Z Joint transform correlator for optical ten poral signals [J]. ApplO pt 2000, 39(45): 6556~ 6560
- [4] LIU D M, SHEN JY, WANG L J Application of the wavelet transform to pattern correlator recognition [J]. Laser technology 2004 28(6): 641~644(in Chinese).
- [5] JAVIDIB, LIJ AM IR H Fetal Binary nonlinear joint transform correlator performance with different thresholding methods under unknown illumination conditions [J]. A pplOpt 1995, 34(5): 886~ 896.
- [6] ZHAO JL, XU Q T, YANG D X et al. Optimized threshold of the binary joint transform correlator [J]. A cta Photonica Sinica, 2002, 31 (9): 1101~1104 (in Chinese).
- BUTT JA, WILKINSON T D. B inary phase on ly reference for invariant pattern recognition with the joint transform correlator [J]. Proc SPIE, 2006, 6234: 62340J-1~62340J-11
- [8] JULIC P T, JUVELIS I, MAR D M U et al. Reduction of the effect of aberrations in a join+transform correlator [J]. Appl Opt 2004 43 (4): 841~849
- [9] V ETOR D R H, KOBER V, DSUE A B Pattern recognition with an adaptive joint transform correlator [J]. ApplOpt 2006, 45(23): 5929 ~ 5941
- [10] ZHONG Sh, JANG J X, LU Sh T et al Binary joint transform correlator based on differential processing of joint transform power speetrum [1], App1Opt 1997, 36(8): 1776~ 1780.
- [11] WANG H X, ZHAO W, LIY X. Multi-object recognition using power spectrum optimized joint transform correlator [J]. Optical Technique, 2006 32(2): 190~195(in Chinese).

438~ 442 (in Chinese).

- [7] POLAN A. Erbium implanted thin film photonic materials [J]. JA P, 1997, 82(1): 1~39
- [8] GU T Zh, ZHU M H, XIA T et al Spectroscopic properties of Er³⁺ doped niobate tellurite glasses [J]. Laser Technology, 2005, 29 (2): 162~164 (in Chinese).
- [9] KOZANECKIA, STEPIKHOVA M, LANZERSTORFER S et al Excitation of E³⁺ ions in silicon dioxide films thermally grown on silicon
 [J]. A PL 1998, 73 (20): 2929~2931.
- [10] WANG X J LE IM K, YANG T *et al.* Coherent effect of E_1^{3+} -Yb³⁺ co-doping on enhanced photolum inescence properties of A l_2O_3 powders by the sol-gelm ethod [J]. OpticalM ateria § 2004(26): 253 ~ 259
- [11] ZHANG I, HU H F, OIC H et al. Spectroscopic properties and energy transfer in Yb³⁺ /E r³⁺ -doped phosphate glasses [J]. OpticalM a-terials 2001 (17): 371~377.
- [12] T NG C C, CHEN Ş YANDLEE H Y. Physical characteristics and in frared fluorescence properties of sol-gel derived E r³⁺-Yb³⁺ codop ed T D₂[J]. JA P, 2003 94(3): 2102~2109
- [13] LI Sh F, ZHANG Q Y. Absorption and photolum inescence properties Er/Yb co-doped soda silicate glasses [J]. Acta Physica Sinica 2005, 54(11): 5462~5467(in Chinese).
- [14] OKADA K, HATTOR I A, KAMESH MA Y. Concentration effect of Cs⁺ additive on the V-A <u>l</u>₂O₃-to-α-A <u>l</u>₂O₃ phase transition [J]. M aterials Letters 2000, 42(3): 175~ 178.

^{(9): 894 ~ 899}